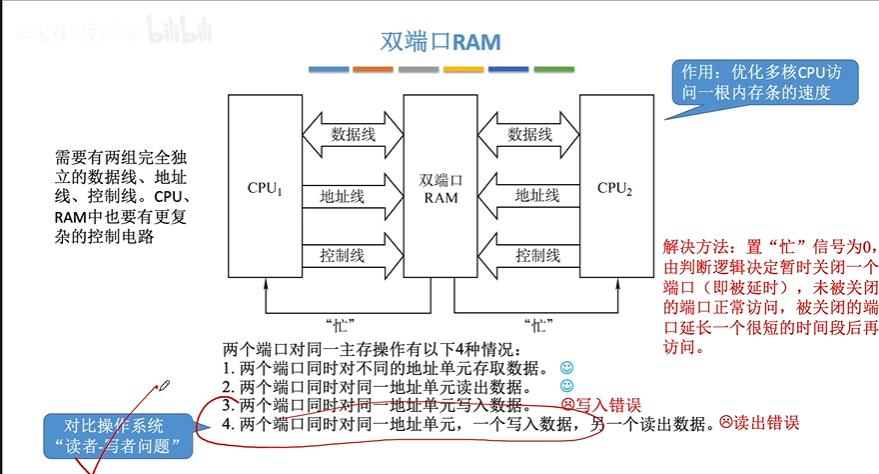
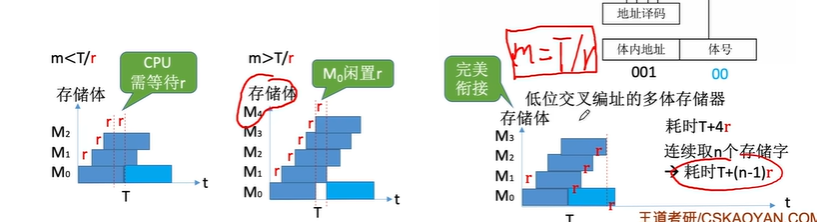
# 双端口RAM

支持两个 CPU 同时访问 RAM。



## 交叉存取度

低位交叉编址为什么最好取 ，其中 m 表示低位交叉编址多体并行存储器的模块数，T表示存取周期，r 表示存取时间（总线传输周期）。



可以看到，当 的时候，M\_2 存取结束之后，M\_0 还未恢复完毕 ；

当 时，当 M\_3 结束时，M\_0 已经可以进行取数，但是 M\_4 占用处理器，造成了 M\_0 不能连续运作 。

所以最好取 , 但是只要 ，流水线就不会间断。

# 多体交叉存储器的体号问题

高位交叉编址，每个模块高位是相同的，作为体号，低位表示体内地址 ；

低位交叉编址，低位为体号，高位是体内地址。

一般来说，交叉编制就是指低位交叉编址了。

比如，**用 16K × 8 的存储芯片组成一个 64K × 8的存储器，交叉编制，求 BFFFH 所在芯片的最小地址。**

显然 4 片就够了。低位交叉编址，看最低的两位，11，所以芯片的最小地址是 0000 0000 0000 0011 = 0003H。